
2SD1138

シリコン NPN 三重拡散形

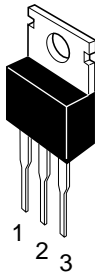
HITACHI

特長

- 低周波高電圧電力増幅用
- TV 垂直偏向出力用
- 2SB861 とコンプリメンタリペア

外観図

TO-220AB



1. Base
2. Collector (Flange)
3. Emitter

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SD1138	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	2	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	5	A
許容コレクタ損失	P_C	1.8	W
	P_C^{*1}	30	W
接合部温度	T_j	150	
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	

【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

電気的特性

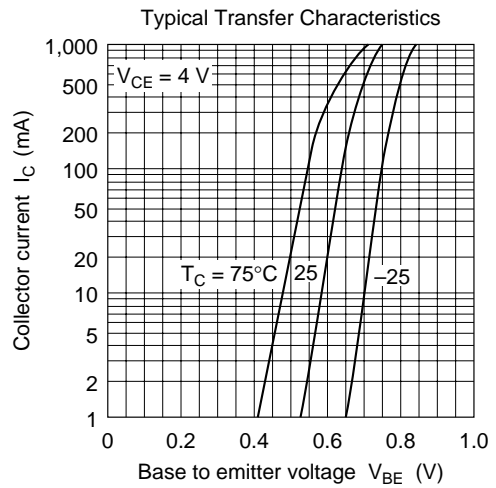
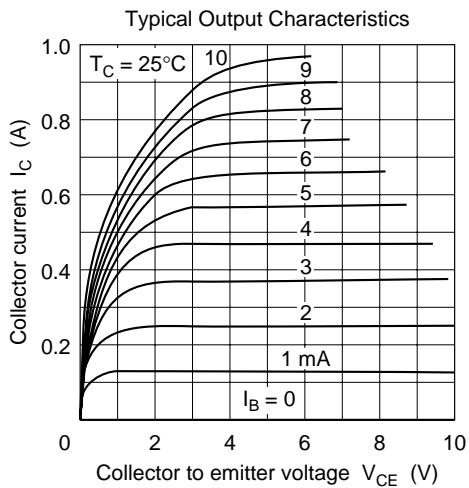
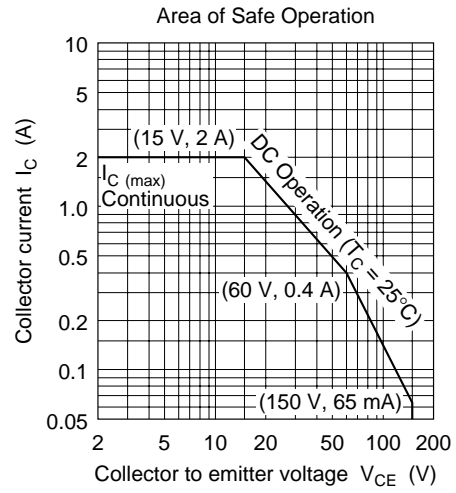
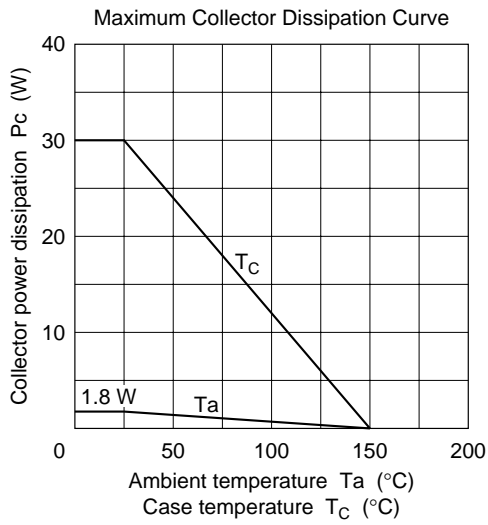
(Ta = 25)

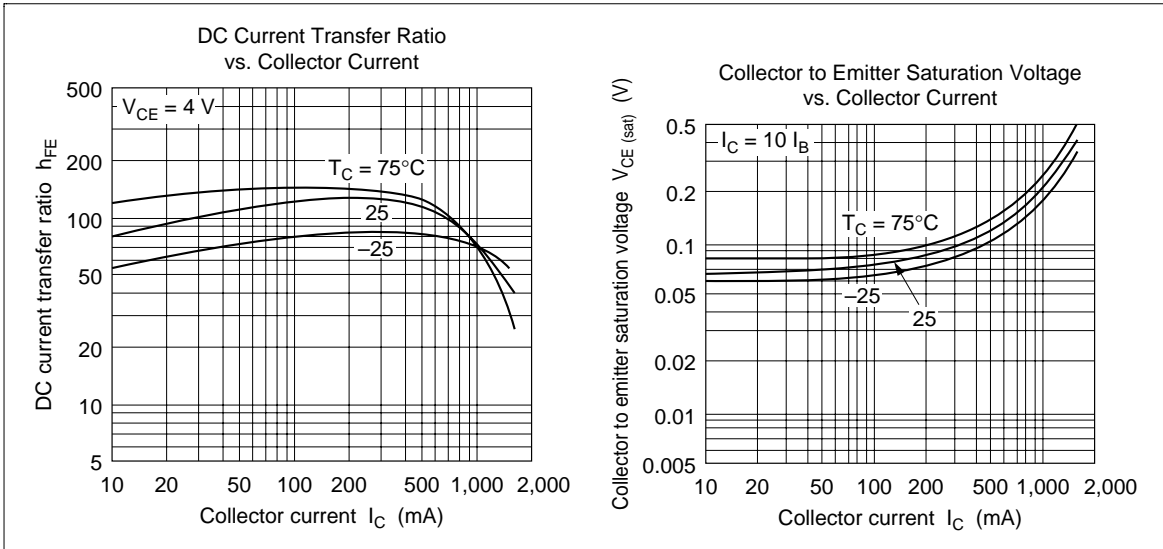
項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	150	—	—	V	$I_C = 50mA, R_{BE} =$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	6	—	—	V	$I_E = 5mA, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	1	μA	$V_{CB} = 120V, I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	60	—	320		$V_{CE} = 4V, I_C = 50mA$
	h_{FE2}	60	—	—		$V_{CE} = 10V, I_C = 500mA^{*2}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	3.0	V	$I_C = 500mA, I_B = 50mA^{*2}$
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	—	1.0	V	$V_{CE} = 4V, I_C = 50mA$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	20	—	pF	$V_{CB} = 100V, I_E = 0, f = 1MHz$

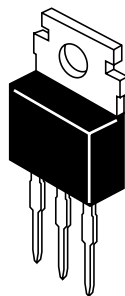
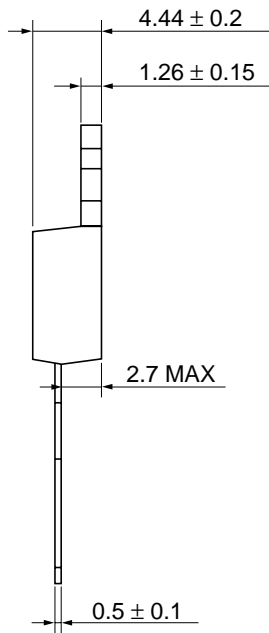
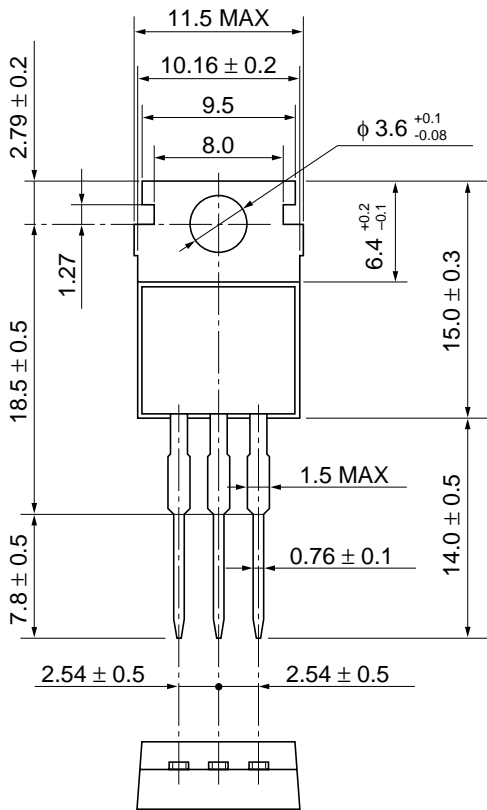
【注】 1. 2SD1138 は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

2. パルス測定

B	C	D
60 ~ 120	100 ~ 200	160 ~ 320







Hitachi Code	TO-220AB
JEDEC	Conforms
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	1.8 g